

Title (en)

Holder, method and device for producing wafers and use of the produced wafers

Title (de)

Träger, Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Wafern sowie Verwendung der hergestellten Wafer

Title (fr)

Support, procédé et dispositif de fabrication de tranches de silicium, ainsi que l'utilisation de la tranche de silicium fabriquée

Publication

EP 2153960 A2 20100217 (DE)

Application

EP 09010524 A 20090814

Priority

DE 102008037652 A 20080814

Abstract (en)

The support (2) has plates with a passage (3), which extends in a longitudinal direction (7) of a material block (1). The material block is cut into wafers, which are suspended at the support. A guide guides rinsing fluid into the passage. The passage guides the rinsing fluid between the wafers. The support is manufactured from a single piece of material. The wafers are cleaned using the rinsing fluid. A cleaning agent is upwardly guided between the wafers under pressure. A contact surface of the support is smaller than a surface (11) of the block due to the passage. An independent claim is also included for a method for manufacturing wafers.

Abstract (de)

Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Träger (2) zur Herstellung von Wafern (5,-5x), die aus einem am Träger (2) angeklebten Materialblock (1) geschnitten sind, wobei der Träger (2) zumindest einen Durchlass (3) zum Zuführen von Reinigungsmittel zwischen die am Träger (2) hängenden Wafer (5,-5x) aufweist. Die vorliegende Anmeldung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Herstellen von Wafern (5,-5x), welches die folgenden Verfahrensschritte umfasst: - Ankleben eines Materialblocks (1) an einen Träger (2); - Schneiden des Materialblocks (1) in am Träger (2) hängende Wafer (5,-5x); - Reinigen der am Träger (2) hängenden Wafer (5,-5x) mit einem Reinigungsmittel; wobei das Reinigungsmittel zumindest zeitweise von oben zwischen die hängenden Wafer (5,-5x) geführt wird. Die vorliegende Anmeldung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Herstellen von Wafern (5,-5x) mit dem oben genannten Verfahren. Weiterhin betrifft die vorliegende Anmeldung eine Verwendung der mit dem Träger (2) und/oder mit dem oben genannten Verfahren und/oder mit der oben genannten Vorrichtung hergestellten Wafer (5,-5x) als Solarzelle, als Halbleiterwafer oder als Quarzwafer.

IPC 8 full level

B28D 5/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

B28D 5/0076 (2013.01); **B28D 5/0082** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 69708168 T2 20020620 - HCT SHAPING SYSTEMS SA CHESEAU [CH]
- DE 102005028112 A1 20061221 - SCHMID TECHNOLOGY SYSTEMS GMBH [DE]

Cited by

EP2458626A1; JP2013531388A; CN107856210A; US2014150826A1; CN104969338A; CN103140336A; WO2014085656A1; WO2012045686A1; WO2012007381A1; EP2711151A1; WO2014045108A1; DE102010052635A1; TWI462172B

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

AL BA RS

DOCDB simple family (publication)

EP 2153960 A2 20100217; **EP 2153960 A3 20120125**; DE 102008037652 A1 20100429

DOCDB simple family (application)

EP 09010524 A 20090814; DE 102008037652 A 20080814